

2024年8月30日

各位

半導体向けエッチングガスCEG[®]34Eの量産開始について

当社は、様々な用途の半導体材料ガスを世界に先駆け開発してきた半導体材料のリーディングカンパニーです。

この度、顧客の量産採用、今後の需要拡大に向けて、2024年8月より当社宇部工場(山口県宇部市)にて、半導体向けエッチングガスCEG[®]34Eの量産を開始しましたのでお知らせいたします。

CEG[®]34Eは高積層化が進む次世代3D NAND Flash向けに開発された、新しいプラズマエッチングガスです。CEG[®]34Eが保有する特性^{*1}は、先端世代の3D NAND Flashのメモリホール^{*2}の深堀エッチング用途として優れた性能を発揮し(図.フォトレジスト膜に対する選択比参照)、高積層3D NAND Flashの技術革新にも貢献いたします。また、同製品は低GWPガスでもあり、GHG(温室効果ガス)排出量の削減にも大きく寄与いたします。

当社は、今後も新たに開発した複数の環境適応型のエッチングガスをAI向け半導体製造用途として上市予定です。

*1 マスクやフォトレジストのエッチングダメージを抑制し、対象となる高積層膜種材質のみを特異的、かつ直線的にエッチングが可能となる特性

*2 横向きに多層に積層された3D NANDメモリセルを直列に貫通するSiチャンネルホール

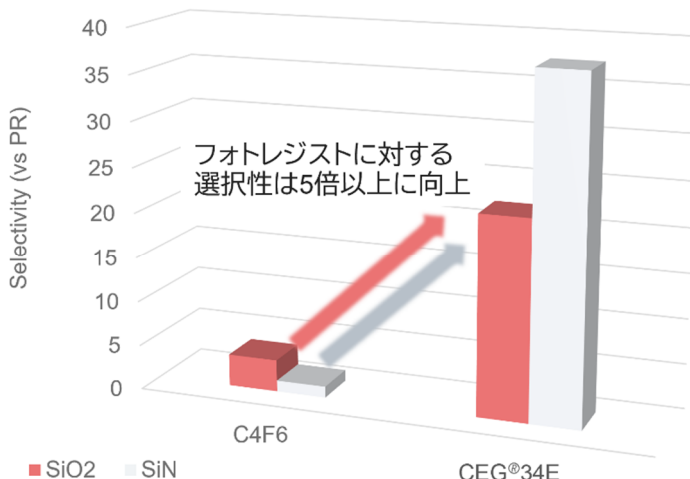


図.フォトレジスト膜に対する選択比(既存ガスであるC4F6ガスとの比較)

以上

《本件に関するお問い合わせ先》

セントラル硝子株式会社

電子材料営業部

TEL: 03-3259-7226